PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-109399

(43) Date of publication of application: 20.04.2001

(51)Int.CI.

G09F 9/30 H01L 29/786 H05B 33/12 H05B 33/14 H05B 33/26

(21)Application number: 11-283181

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

04.10.1999

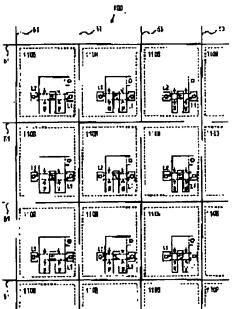
(72)Inventor: YAMADA TSUTOMU

(54) COLOR DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display device wherein white balance of each color display pixel can easily be controlled without making a circuit configuration complex.

SOLUTION: This is a display device wherein display pixels 110, each of which is provided with an EL element 60 sequentially laminating an anode 61, an emitting layer 63, and a cathode 66 and emitting each color, and a TFT 40 for driving the EL element supplying a current to each EL display element, are arranged in a matrix form, and as for the sizes (W/L) of the EL element driving transistors TFT 40 connected with respective color display pixels 110R, 110G, 110B, the TFT for the green display pixel 110G having the best luminous efficiency in the luminous layer 63 of the EL element is the smallest, and the TFTs of the display pixels 110G are increased in size in order of red and blue as their luminous efficiencies become lower.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 08.04.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2003-06869

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

23.04.2003

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出辦公司番号 特別2001-109399 (P2001-109399A)

(43)公開日 平成19年4月20日(2001.4.20)

(51) Int.CL'	1891正月	FI		7. 72	⊢(* (***)
G09F 9/30	3 3 8		9/30	338 3	K007
HO1L 29/788			3/12	B 5	C094
H05B 33/12		33	3/14	A 5	P110
33/14		35	3/26	2	
33/26		HOLL 28	9/78	812B	
,		岩空間 求	未開求 間	交項の数10 OL	(全 9 頁)

(21)出資銀子 特別平11-283181 (71)出版人 0000(1889) 三并電腦模式会社

(22)出闢日 平成11年10月4日(1999.10.4)

大阪府守口市京阪本置名丁目5番6号

(72) 発明者 山田 努

大阪府守口市京阪本理2丁目5층6号 三

洋電機株式会社内

(74)代理人 100111383

押理士 芝野 正雅

Fターム(1945) SRD07 ABOS BAOS CAO1 CBO1 DAO2

EA02

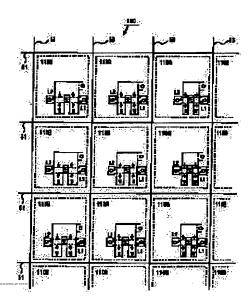
50094 AAO8 BAO3 BA12 BA29 CA19 CA24 BAO3 BAO4 BAO7 BA10

5F110 B802 CC02 CC08 GG28 GG29

(54) 【発明の名称】 カラー表示装置

【課題】 各色の表示画素のホワイトバランスを回路構成を複雑にすることなくかつ容易に制御することができる。 高表示装置を提供する。

「関決手段」 陽極61、発光層63及び陰極66を順に検層し各色を発光する日上素子60、及び個の日上表示素子に电流を供給する日上素子800別円下下40を備えた表示画素110をマトリックス状に配列された表示。 装置であって、各色の表示画素110を、110日に接続された日上素子駆動用下FT40のトランジスタサイズ(W/L)の大きさは、日上素子の発光層63の発光効率が最もよい緑色の表示画素110の下下Tの場合が最も小さく、発光効率が低い赤色及び青色の表示画素の下FTの順に大きくなっている。



【特許請求の範囲】

[請求項 1] 各表示画素に、自発光素子と、該自発光素子に接続され転流を供給する駆動用薄膜トランジスタとを備えたカラー表示装置において、いずれかの色の表示画素と他の色の表示画素で前記駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズが異なっていることを特徴とするカラー表示装置。

【請求項2】 各表示画素に、自発光素子と、該自発光素子に電流を供給するタイミングを制御するスイッチング用薄膜トランジスタど、前記自発光素子に接続され電流を供給する駆動用薄膜トランジスタとを備えたカラー表示装置において、いずれかの色の表示画素と他の色の表示画素で前記駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズが異なっていることを特徴とするカラー表示装置。

[請求項3] 前記トランジスタサイスは前記自発光素 子の発光効率に応じて設定されていることを特徴とする 請求項1又は2に記載のカラー表示装置。

[請求項4] 発光効率が高い自発光素子に接続された 駆動用準限トランジスタのトランジスタサイズを、発光 効率が低い自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジ スタのトランジスタサイズよりも小さくしたことを特象 とする請求項3に記載のカラー表示装置。

【請求項5】 最も発光効率が高い自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズを、他の発光効率の自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズよりも小さくしたことを特徴とする請求項3に記載のカラー表示装置。

【請求項 5】 前記最も発光効率が高い自発光素子は緑色であることを特徴とする請求項5に記載のカラー表示
装置。

【請求項7】 最も発光効率が低い自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイスを、他の発光効率の自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズよりも大きくしたことを特徴とする請求項31に記載のカラー表示装置。

【請求項 B】 前記最も発光効率が低い自発光素子は赤色又は赤色であることを特徴とする請求項フに記載のカラー表示装置。

【諸求項9】 発光効率が低くなるにつれて前記自発光素子駆動用薄限トランジスタのトランジスタサイズが頂に大きくなることを特徴とする諸求項3に記載のカラー表示装置。

【詩求項1°0】 前記自発光素子はエレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする詩求項17万至9のうちいずれが1項に記載のカラー表示装置。

[発明の詳細な説明]

【発明の属する技術分野】本発明は、自発光素子、例え ばエレクトロルミネッセンス(Electro Luminescence: 以下、「EL」と称する。)素子と、薄膜ドランジスタ (Thin Film Transistor、以下、「TFT」と称す る。)を備えた表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、自発光素子である日上素子を用いた日上表示装置が、CRTやLCDに代わる表示装置として注目されている。

【0003】また、そのビレ素子を駆動させるスイッチング素子としてエドエを備えた表示装置も研究開発されている。

(0004) 図2に有機EL表示装置の等価回路図を示し、図3に有機EL表示装置の表示画素付近を示す平面図を示し、図4(a)に図3中のA-A執に沿った断面図を示し、図4(b)に図3中のB-B執に沿った断面図を示す。また、図5には、有機EL表示装置の表示画素配列を示す。

【0005】図2及び図3に示すように、ゲード信号録 51とドレイン信号録52とに囲まれた領域に表示画素 11.0が形成されており、マトリクス状に配置されている。また、両信号録51、52の交点付近にはスイッチング用下Fである第1の下Fで30が備えられており、 ぞの下Fで30のソース13 sは後述の保持容量電極録54との間で容量をなす容量電極55を兼れるとともに、EL来子駆動用下Fである第2の下Fで40のゲート41に接続されている。第2の下Fでソース43 sは有機EL素子50の関極61に接続され、他方のドレイン43 dは有機EL素子50に供給される電流源である駆動電源録53に接続されている。

【0006】また、ゲート信号線51と並行に保持整量 電極線54が配置されている。この保持容量電極線54はグロム等から成っており、ゲード経線膜12を介して TFTのソース135と接続された容量電極55との間で電荷を審核して容量を成じている。この保持容量56は、第2のTFT40のゲード電極41に印加される電圧を保持するために設けられている。

【00.07】図4に示すように、有機日上表示装置は、 カラスや合成樹脂などから成る基板又は導電性を有する 基板あるいは半導体基板等の基板10上に、TFT及び 有機日上素子を順に被骨形成して成る。ただし、基板1 0として導電性を有する基板及び半導体基板を用いる場合には、これらの基板10上にSiO2やSiNなどの 絶縁膜を形成した上に第1、第2のTFT及び有機日上表示素子を形成する。

【0008】まず、スイッチング用のサドエである第1 のエドエタのについて説明する。

【10009】図4(e)に示すように、石英ガラス、無アルカリガラス等からなる経緯性基板10上に、半導体 映(p-Si-限)からなる能動層13、その上にゲート 経縁映12、及びクロム(Cr)、モリブデン(Mo) などの高融点金属からなるゲート電優11を兼ねたゲー ト信号線51が順に接続されている。またA)から成る トレイン信号線52を備えており、有機Eに素子の駆動 電源でありA)から成る駆動電源線53が配置されてい る。

【0010】そして、ケート電極11、ゲード絶縁限12上の全面には、SIO2限、SIN限及びSIO2限の順に練習された層間絶縁限15が形成されており、ドレイン13はに対応して設けたコンタクドホールにAI等の金属を充填したドレイン電極15が設けられ、更に全面に有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁限17が形成されている。

[0011]次に、有機Eビ素子の駆動用のTFTである第2のTFT40について説明する。

【0012】図4(6)に示すように、石英ガラス、無 アルカリガラス等からなる絶縁性基板 1.0 上に、半導体 膜 (p-S)膜) からなる能動層43、ゲード絶縁膜1 2、及びCr、Moなどの高融点金属からなるゲート電 -極4 1が順に形成されており、その能動層43には、チ ・ヤネル43cと、このチャネル43cの両側にソース4 3 s 及びドレイン4:3 d が設けられている。 そしで、ゲ 2膜、SIN膜及びSIO2膜の順に積層された摩間絶縁 膜15を形成し、ドレイン43dm対応して設けたコン タクトホールにAIN等の金属を充填して駆動電源に接続。 された駆動電源線53か配置されている。更に全面に例 えば有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜1 フを備えている。そして、その平坦化絶縁膜 17 のソー ス4/3 s に対応 じた位置にコンタクトホールを形成し、 このコンタクトホールを介してソース4.3 s とコンタク トレだしてO(Indium Thin Oxide)から成る透明電 極、即ち有機EL素子の陽極51を平坦化絶縁膜17上 に設けている。

【0.013】有機EL素子6.0は、LT〇等の透明電極。 から成る陽極 5:10 MT:DATA (4,4-bis(3-methylph eny (pheny lamino) b (pheny l) などから減る第1ホール輪 送層、及びTPD (4,4,4-tr.is(3-methylphenylphenyla mino) triphenylanine) などからなる第2ホール輸送層 のホール輸送層6.3、キナクリドン(Quinacridone)誘 · 雄体を含むBe b g2(10-ペンジ(h) キノリノールー ベリリウム雑体)などから成る発光層 64及びBeba 2などから成る電子輸送層からなる発光素子層65、マ グネシウム(Me)とAe(銀)の合金、あるいはフッ 化リチウム(LiF)とAlの結層体などから成る陰極 6.6 がこの順番で袪層形成された構造である。その発光 素子層65の発光材料を所定の色を発光する材料を選択 することにより、それぞれの色を発光する表示画素が排 成され、図5に示すように、各色の表示画素をマトリク ス状に配置することで有機EL表示装置が構成されてい る.

【0014】また有機EL素子は、陽極から注入された。

ホールと、陰極から注入された電子とか発光層の内部で 再結合し、発光層を形成する有機分子を励起して励起子 が生しる。この励起子が放射失活する過程で発光層から 光が放たれ、この光が透明な陽極から透明絶縁を振を介 して外部へ放出されて発光する。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】このように、も色を発 光する各表示画素には、その表示画素 1.10 ことに接続 された有機に上来子を駆動するためのE L素子駆動用す ドエが接続されているが、これらのチャーはいずれのト ランジスタサイズ、即ちエテエの手導体膜とケート電極 とが重量じた領域のチャネルのチャネル幅Wとチャネル 長に(図3の場合には、L= L 1 + L 2)との比W/L は均一なエデエである。

(00.16) また。各色を発光する各表示画素の発光層の発光効率は、その発光層を構成する有機発光材料によって各色ごとに異なっている。

【00.17】従って、各色のその発光効率に応じて、異 なる電流値を各色の有機モレ業子に供給し、他の色と同 じレベルの輝度を得て各色のボワイトバランスをとるた。 めには、駆動電源の電流値を各色でとに異ならせるか。 あるいは各表示画素に接続された第1のエFTに供給す るトレイン信号の電位を各色に応じて変える必要があ る。即ち、発光効率の低い色の発光層を有する有機EL 素子には、発光効率の高い色の発光層を有する有機EL 素子に比べて多くの電流を流さなければならなかった。 【〇〇18】しかしながら、駆動電源の電流値を各表示・ 画素の色ごとに異ならせるためには駆動電源線を各表示 画素を配置した領域内を複雑に配置しなければならず、 また、第1のTFTに供給するドレイン信号の電位を各 色に応じて変えるためには、第1のTFTに信号を供給 ずる回路構成が複雑になってしまうという欠点があっ ter

[0019] そこで本発明は、上記の従来の欠点に鑑みて為されたものであり、日に素子を備えた各色の表示画素の日に素子駆動用エドエのサイズを発光効率に応じて異ならせることにより、各色の表示画素のホワイトバランスを回路構成を推進にすることなくかつ容易に制御することができる日に表示装置を提供することを目的とする。

[0020]

【課題を解決するための手段】本発明の表示装置は、各表示画素に、自発光素子と、該自発光素子に接続されて、 遠を供給する自発光素子駆動用薄膜トランジスタとを備えたカラー表示装置において、各色の表示画素のうちい すれかの色の表示画素の前記自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズが異なっているものである。

【0021】また、上述の表示装置は、前記トランジス タサイスは前記自発光素子の発光効率に応じて設定され ている表示装置である。

【0.022】更に、発光効率が高い自発光素子に接続さ れた自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタ サイスを、該自発光素子の発光効率よりも低い発光効率 の自発光素子に接続された自発光素子駆動用達膜トラン ジスタのトランジスタサイスよりも小さくした表示装置。 である.

【0023】また、最も発光効率が高い自発光素子に接 紡された自発光素子駆動用達膜ドランジスタのトランジ スタサイスを、他の発光効率の自発光素子に接続された 自発光素子駆動用液膜トランジスタのトランジスタサイ - スよりも小さくした表示装置である。

[0024] 更にまた、前記最も発光効率が高い自発光 素子は緑色である表示装置である。

【0025】また、最も発光効率が低い自発光素子に接 統された自発光素子駆動用液膜トランジスタのトランジ スタサイスを、他の発光効率の自発光素子に接続された **自発光素子駆動用強限トランジスタのトランジスタサイ** スよりも大きくした表示装置である。

【0026】また、前記最も発光効率が低い自発光素子。 は赤色又は赤色である表示装置である。

[10/0/2/7] また、発光効率が低くなるにつれて前記自 発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズ が順に大きくなる表示装置である。

[0028] また、前記自発光素子はエレクトロルミネ ッセンス素子である表示装置である。

[0.02.9]

【発明の実施の形態】本発明の表示装置について以下に 説明する。

【0030】図1は、本発明の表示装置をEL表示装置 1.0 0に応用した場合を示し、日じ素子に電流を供給す。 るEL素子駆動用TFTの一部を拡大した平面図であ

【0031】なお、同図には各表示画素が、赤色(11 OR) 、緑色 (1-1-OG) 及び青色 (1-1-OB) を発光: する場合であって、前述の図3に示す表示画素のうち、 表示画素に配置された駆動用でド下のチャネル4.3 c.、 ツース435及びドレイン43dを備えた能動層と、ゲ ートとのみを拡大して示している。

[0032] 同図に示すように、日 L表示装置 100に は、複数のケート信号線5.1が同図の左右方向に、また 複数のドレイン信号線53か同図の上下方向に配置され ており、それらの信号執5 15、5/3 は互いに交差じてい。 る.

【0.033】それらの交点付近には、図3に示したよう に、両信号数51,53に接続され日上未子60に電流 を供給するタイミングを制御するスイッチング用工FT 30と、そのTFT30のソース・13 sにケートが接続。 され有機EL素子60に電流を供給しその有機EL素子。 60を駆動するEL素子駆動用TFT40と、そのEL

素子駆動用TFT 40のソース43 s に関極6 1が接続 された有機EL素子6.0が形成されており、また、図1 に示すように、各色の表示画素 1 1 0 R. 1 1 0 B. 1 1.DGはマトリックス状に配列されている。有機モレ素 子60の構造は従来の技術の欄で説明したものと同じで あるので説明は省略する.

【0034】ここで、各表示画素 110R, 110B, 1:1:OGに接続されたEL業子駆動用工FTのトランジ スタサイズW/Lについて説明する。

【0035】なお、本発明においては、TFTのトラン シスタサイスとは、TFTのチャネルのチャネル値Wと チャネル長しとの比、即ちW/しのことをいうものとず

[10036] 本実施の形態においては、緑色の表示画素。 に配置する発光材料が最も発光効率が高く、赤色の表示 画素に配置する発光材料の発光効率が次に高く、青色の 表示画素に配置する発光材料の発光効率が最も低い場合 である。即ち、緑色の発光効率Geffと、赤色の発光効 率Reffと、青色の発光効率Beffの比が、Geff:Ref .大:: Bett = 1:0 :: 3。8:: 1:: 8.の場合について説明す

【0037】図1において日上秦子駆動用下F下のドラ ンジスタサイズW/LのLは、L 1 + L2である。 【0038】緑色の表示画素の発光素子層の発光材料の 発光効率が最も高いので、各表示画素の駆動用工FTの トランジスタサイズ(W/L)のうち、緑色表示画素 1 1 DGのW/Lを最も小さくしてTETが形成されてい

【0039】他の色の表示画素110R,110Bの₩ / Lは、緑色の表示画素の1 1 D GのW/ Lよりも大き く形成されている。

【0040】具体的には、各色の発光効率の比が、Gef f:: Reff: Beff= 1.0:3:8:1:8であるので: 各エFエのチャネル長し= 5 μ m の→定とした場合は。 緑色表示画素のTFTのチャネル幅WG= 5 μ m、赤色 表示画表のTFTのチャネル幅WR= 1.3 μm、青色表 示画素のチャネル幅WG= 28 μ m とする。

[0041] 即5、WG: WR: WB= 1/Geff: 1/R eff: 1/Beff= 1/10:1/3.8:1/1.8= 1:2. 6:5. 6=5:13:28となる。

【0042】このように、W/Lを各色の発光効率に応 じて設定することにより、EL駆動電源の電流値を各色 ごとに調整して供給する必要もなく、また、ドレイン信 号線からのドレイン信号がスイッチング用TFT30の ソースから 日上駆動用TFT40のケードに供給される **電圧を供給する際に、各色ごとに調整する必要もなくな** る。それらの各種圧を調整することになると、駆動電源・ 線が E L表示装置の表示領域内を複雑に配置することに なりそれによって断線や短絡発生の原因となるととも

に、EL素子駆動用のTFTのゲードに供給する電圧を

制御するためにスイッチング用エドエのドレインに供給する電圧を制御するための回路を別途設ける必要も無くなる。

【0.04.3】なお、図1においでは、チャネル幅Wとチャネル長しのうち、チャネル幅Wを一定にした場合を示しているが、本発明はそれに限定されるものではなく、チャネル長しを一定として、チャネル幅Wを各色の表示画表で異ならせる。即ち、緑色表示画素のチャネル帽Wを緑色表示画素の場合に比べ大きぐし、更に赤色表示画素のTFTのチャネル幅Wを緑色表示画素の場合に比べ大きぐし、更に赤色表示画素のTFTのチャネル幅Wを大きくする。

【0.04.4】 このように、各色の表示画素に接続された。 E L駆動用下FTのW/Lをその表示画素に配置された 発光素子層の発光材料の発光効率に応じて異ならせることにより、駆動電源からの電圧を各色ごとに異ならせそれによって駆動電源線が複雑に自し表示装置の表示積域 内を配置することが無くなるとともに、スイッチング用 TFT30に供給されるドレイン信号を各色ごとに異ならせそれによって回路構成が複雑に成ることを防止することがかできる。

【0045】また、本実施の形態においては、発光する各色を赤、緑、緑とした場合、発光効率の扇も良い緑色の表示画素に接続された日に駆動用下FTのドランジスタサイズW/Lを扇も小さく、次に発光効率の悪い赤色の表示画素に接続された日に駆動用下FTのW/Lを大きくし、扇も発光効率の悪い赤色の表示画素に接続された日に駆動用下FTのW/Lを扇も大きくした場合を示したが、発光層の発光材料によっては、扇も発光効率の良い色、例えば緑色と、次に発光効率の良い色、例えば赤色の表示画素とが同しW/Lであって、残りの発光がまた。発光効率が最も悪い赤色と次に発光効率が良くない赤色の表示画素のW/Lが同しであって、残りの発光効率の最も良い色、例えば緑色の表示画素のW/Lがけるって、残りの発光効率の最も良い色、例えば緑色の表示画素のW/Lがいきくても、本願特有の効果を察することができる。

【0046】また、本実施の形態においては、赤色の表示画素110Rと春色の表示画素110BのW/Lの方が大きい場合について説明したが、赤色の表示画素110Rと春色の表示画素110BのW/Lの大きさの順番は、それらの発光効率が材料によって異なるため、材料によって入れ替わることがある。表示画素の各色をR、G、Bとした場合には、発光効率が最も高いGの表示画素110Gに接続されたTFTのW/Lを最も小さくする。

【0047】また、表示のホワイトバランスをとる場合、材料の発光効率以外にも、各色の発光材料の色度に応じて各色のエテエに流れる電流値を調整するが、その色度に応じてトランジスタサイズを調整しても良い。

【0·0·4·8】また、本実施の形態においては、同じ色の表示画素が上下方向に並んだいわゆるストライプ配列の

場合を示したが、本発明はそれに限定されるものではな く、いれゆるデルタ配列でも採用は可能であり同様の効果を得ることができる。

(00.4.9) また、各色の発光層の材料としては、各色発光層の場合には例えばの×D(オキサジアジール)、AZM(アジメチンー亜鉛錐体)などを用い、赤色発光層の場合には例えばZnPr(ポリフィリンー亜鉛錐体)などを用い、最色発光層の場合には例えばBeBa 2(1.0-ベンジ(6)キンリノールーベリリウム錐体)などを用いることができる。

【0050】このように、有機EL表示装置の各色の表 示画素が、発光層の発光効率が最も良い緑色の表示画素 と、この緑色の表示画素の発光効率よりも低い発光効率。 である赤色の表示画素と、赤色の表示画素の発光効率よ りも更に低い発光効率である青色の表示画素とから成っ ている場合においては、緑色の表示画素に接続された日 L素子駆動用TFTのW/Lが赤色の表示画素に接続さ れたEL素子駆動用TFTのW/ Lより小さいかあるい は装しく且つ赤色の表示画素に接続された日上素子駆動> 用エFIのW/しが各色の表示画素に接続されたFL素 子駆動用のエドエのW/エよりも小さくするごと担よ り、駆動電源からの電流値を各色の表示画素ごとに異な らせるための駆動電源配線を複雑に配置する必要が無く なり、また、スイッチング用エドエに供給するドレイン 信号にバイアス電圧を各色の信号ことに異ならせるため の周辺の回路を複雑にすることなく、容易に各色の表示 画素の発光材料の発光効率に応じて電流値を制御するこ とができるとともに、それによって容易に各色のホワイ ドバランスをどることができる。

(0051) また、毎色の表示画素に接続されたTFTのW/Lを上述のようにすることにより、毎色の輝度のパランスの制御が可能であることから、容易に良好なホウイトパランスのとれた表示を得ることができる。

【0052】なお、本実施の形態においては、EL素子 駆動用TFTは、ゲート電極がゲート絶縁膜を介して能 動層の上方に設けられたいわゆるトップゲード構造を確 えた場合を説明したが、本発明はゲート電極がゲート絶 縁膜を介して能動層の下方に設けられたいわゆるボトム ゲート構造を備えた場合にも同様の効果を奏することができる。

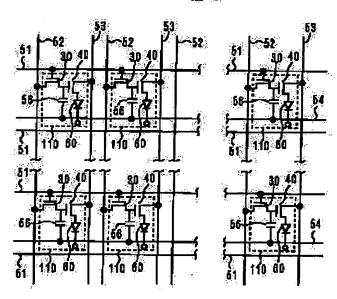
【0053】また。本実施の形態においては日上表示装置のうち数画素分を示して説明したが、本発明はVGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×758)、SXGA(1280×10)24)など、任意の表示画素数に適用可能である。 (0054)

[発明の効果] 本発明の表示装置によれば、各色の表示 画素のホワイトバランスを回路構成を複雑にすることな くかつ容易に制御することができる日上表示装置を得る ことができる。

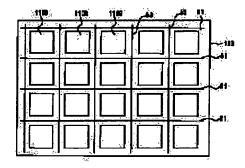
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の日に表示装置の各色の表示画素の下F	1"1.0 R	赤色の表示画素
丁の一部拡大平面図である。	1 1 0 G	緑色の表示画素
【図2】本発明のEL表示装置の等価回路図である。	3.0	第10TFT
【図、3】EL表示装置の表示画素付近を表す平面図であ	4.0	第2のTFT
る。	511	ケート信号線
【図4】EL表示装置の断面図である。	5.2	ドレイン信号線
【図 5】 EL表示装置の各色の表示画素の配列を示す平	5 3	駆動電源線
面図である。	5′4	保持容量電極線
【符号の説明】	1:00	EL表示装置
1 1 0 B 春色の表示画素		

[22]

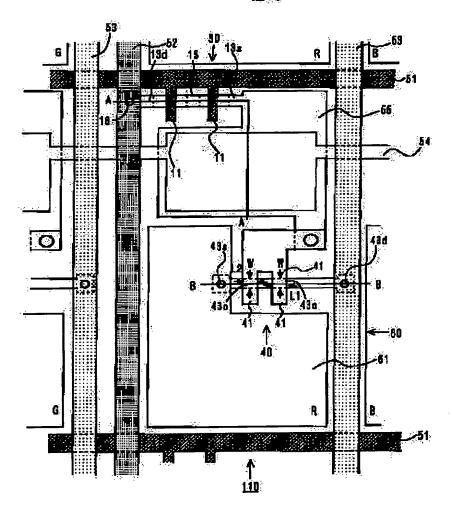


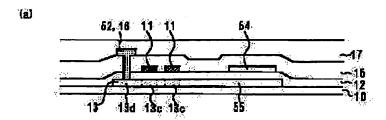
[25]

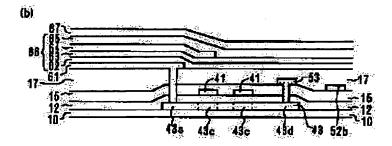


		100 7		
	53	53	69	 59
\$1	11GB	11 0 R	1106	110B
	6 1 100 12 1 100 11 1 100	10 to		
<u>δ</u> 1	110B	110R	1106	11 0 B
51	110B	1108	11 00	110B
51	1108	110R	110G	1108

Δ.







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.